

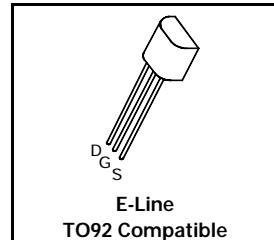
# N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET

ISSUE 2 - MARCH 94

**ZVN2106A**

## FEATURES

- \* 60 Volt  $V_{DS}$
- \*  $R_{DS(on)}=2\Omega$



## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

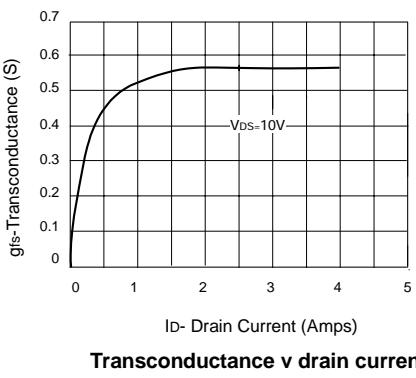
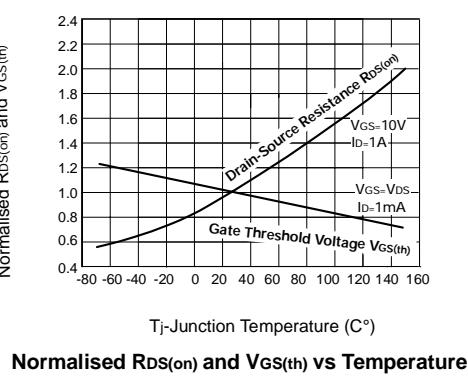
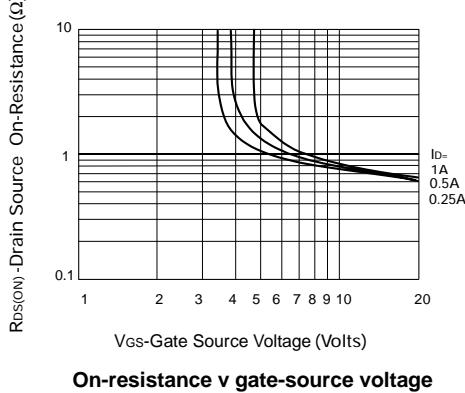
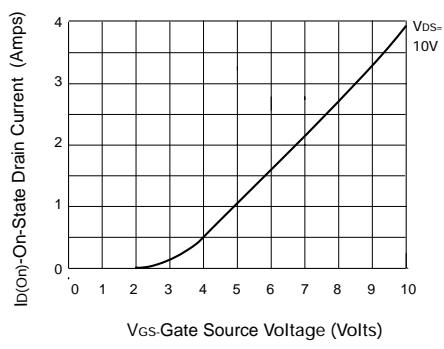
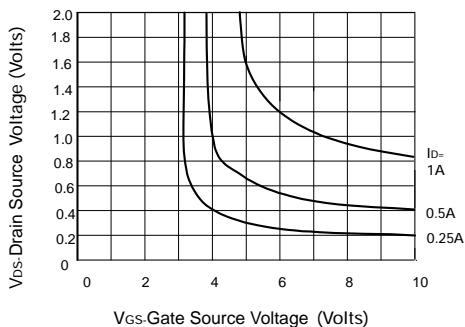
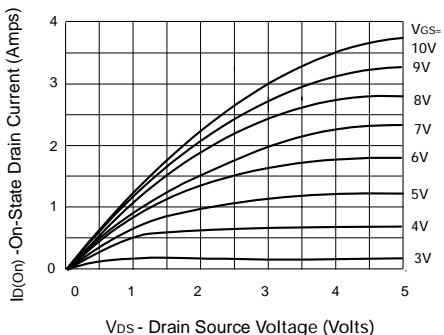
| PARAMETER  | SYMBOL         | VALUE       | UNIT |
|--|----------------|-------------|------|
| Drain-Source Voltage                             | $V_{DS}$       | 60          | V    |
| Continuous Drain Current at $T_{amb}=25^\circ C$ | $I_D$          | 450         | mA   |
| Pulsed Drain Current                             | $I_{DM}$       | 8           | A    |
| Gate Source Voltage                              | $V_{GS}$       | $\pm 20$    | V    |
| Power Dissipation at $T_{amb}=25^\circ C$        | $P_{tot}$      | 700         | mW   |
| Operating and Storage Temperature Range          | $T_j; T_{stg}$ | -55 to +150 | °C   |

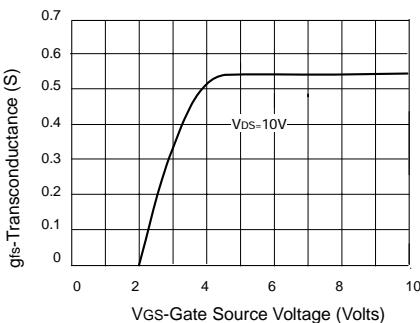
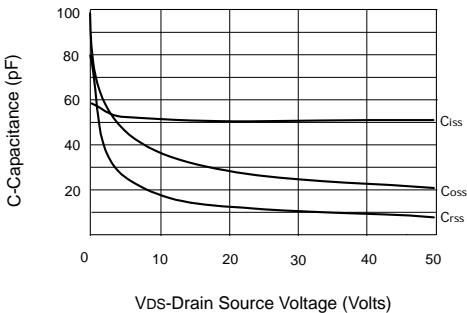
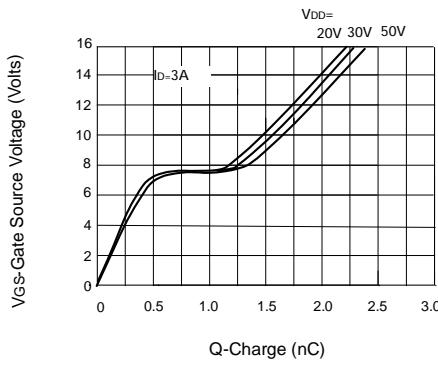
## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ C$ unless otherwise stated).

| PARAMETER                                   | SYMBOL       | MIN. | MAX.       | UNIT          | CONDITIONS.  |
|---|--------------|------|------------|---------------|--|
| Drain-Source Breakdown Voltage              | $BV_{DSS}$   | 60   |            | V             | $I_D=1mA, V_{GS}=0V$   |
| Gate-Source Threshold Voltage               | $V_{GS(th)}$ | 0.8  | 2.4        | V             | $ID=1mA, V_{DS}=V_{GS}$  |
| Gate-Body Leakage                           | $I_{GSS}$    |      | 20         | nA            | $V_{GS}=\pm 20V, V_{DS}=0V$  |
| Zero Gate Voltage Drain Current             | $I_{DSS}$    |      | 500<br>100 | nA<br>$\mu A$ | $V_{DS}=60 V, V_{GS}=0$<br>$V_{DS}=48 V, V_{GS}=0V,$<br>$T=125^\circ C(2)$ |
| On-State Drain Current(1)                   | $I_{D(on)}$  | 2    |            | A             | $V_{DS}=18V, V_{GS}=10V$   |
| Static Drain-Source On-State Resistance (1) | $R_{DS(on)}$ |      | 2          | $\Omega$      | $V_{GS}=10V, I_D=1A$   |
| Forward Transconductance (1)(2)             | $g_{fs}$     | 300  |            | $mS$          | $V_{DS}=18V, I_D=1A$   |
| Input Capacitance (2)                       | $C_{iss}$    |      | 75         | pF            | $V_{DS}=18 V, V_{GS}=0V, f=1MHz$   |
| Common Source Output Capacitance (2)        | $C_{oss}$    |      | 45         | pF            |  |
| Reverse Transfer Capacitance (2)            | $C_{rss}$    |      | 20         | pF            |  |

# ZVN2106A

## TYPICAL CHARACTERISTICS



**TYPICAL CHARACTERISTICS****Transconductance v gate-source voltage****Capacitance v drain-source voltage****Gate charge v gate-source voltage**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.